

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Направление подготовки/специальность: 11.03.04 Электроника и нанoeлектроника

Наименование образовательной программы: Нанотехнология в электронике

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины
ФИЗИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Блок:	Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Часть образовательной программы:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
№ дисциплины по учебному плану:	Б1.Ч.01.16
Трудоемкость в зачетных единицах:	8 семестр - 4;
Часов (всего) по учебному плану:	144 часа
Лекции	8 семестр - 28 часа;
Практические занятия	8 семестр - 14 часов;
Лабораторные работы	не предусмотрено учебным планом
Консультации	проводится в рамках часов аудиторных занятий
Самостоятельная работа	8 семестр - 101,7 часа;
в том числе на КП/КР	не предусмотрено учебным планом
Иная контактная работа	проводится в рамках часов аудиторных занятий
включая: Контрольная работа Расчетно-графическая работа	
Промежуточная аттестация:	
Зачет с оценкой	8 семестр - 0,3 часа;

Москва 2023

ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

Преподаватель

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Холодный Д.С.
	Идентификатор	R0bac9dac-KholodnyDS-6393810f

Д.С. Холодный

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Холодный Д.С.
	Идентификатор	R0bac9dac-KholodnyDS-6393810f

Д.С. Холодный

Заведующий выпускающей
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Славинский А.З.
	Идентификатор	R99b3b9ab-SlavinskyAZ-c08f5214

А.З. Славинский

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: Изучение физических основ полупроводниковых композиционных материалов, формирование знаний в области современных тенденций развития нанoeлектроники. Формирование научной основы для осознанного и целенаправленного использования полученных знаний при создании элементов, приборов и устройств на базе композиционных материалов

Задачи дисциплины

- 1. изучение студентами композиционных полупроводниковых и диэлектрических материалов и изделий на их основе;
- 2. изучение классификации и общая характеристика методов получения композиционных материалов;;
- 3. получение новых фундаментальных знаний и практических навыков в области определения структурных свойств и физических основ синтеза композиционных материалов;
- 4. приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе поведения микро и наночастиц, а также систем на их основе;
- 5. формирование навыков решения простейших задач квантовой механики и статистической физики применительно к композиционным материалам;
- 6. приобретение студентами знаний о методах математического моделирования как основы изучения функционирования композиционных материалов;
- 7. формирование знаний о фундаментальных физических основах и закономерностях и механизмах переноса носителей заряда в системах пониженной размерности, об электрических, оптических, магнитных, механических свойствах композиционных материалов.

Формируемые у обучающегося **компетенции** и запланированные **результаты обучения** по дисциплине, соотнесенные с **индикаторами достижения компетенций**:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ПК-3 Способен участвовать в проведении технологических процессов изготовления материалов электронной техники, микро- и нанoeлектроники	ИД-1ПК-3 Знает базовые технологические процессы изготовления материалов электронной техники, микро- и нанoeлектроники	знать: - 1. основные процессы, протекающих в композиционных материалах электронной техники,; - 2. основные физико-математические модели, используемые в области физики полупроводниковых композиционных материалов. уметь: - 1. применять физико-математические модели при разработке композиционных материалов; - 2. объяснять на основе физико-математических моделей характеристики полупроводниковых композиционных материалов.
ПК-3 Способен участвовать в проведении технологических процессов изготовления материалов электронной техники, микро- и	ИД-2ПК-3 Знает об физико-химических основах 9 технологических процессов изготовления материалов электронной техники, микро- и нанoeлектроники	знать: - 4. физико-химические свойства композиционных материалов;; - 3. влияние структурных характеристик на свойства композиционных материалов;.

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
наноэлектроники		уметь: - 3. интерпретировать электрофизические характеристики полупроводниковых и диэлектрических композиционных материалов; - 4. рассчитывать электрические характеристики полупроводниковых композиционных материалов для различных областей их использования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе Нанотехнология в электронике (далее – ОПОП), направления подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, уровень образования: высшее образование - бакалавриат.

Базируется на уровне среднего общего образования.

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины/формы промежуточной аттестации	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы										Содержание самостоятельной работы/ методические указания
				Контактная работа							СР			
				Лек	Лаб	Пр	Консультация		ИКР		ПА	Работа в семестре	Подготовка к аттестации /контроль	
КПР	ГК	ИККП	ТК											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Основы физики композиционных материалов	36	8	8	-	4	-	-	-	-	-	24	-	<p><u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Основы физики композиционных материалов"</p> <p><u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение материала по разделу "Основы физики композиционных материалов" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях</p> <p><u>Подготовка к контрольной работе:</u> Изучение материалов по разделу Основы физики композиционных материалов и подготовка к контрольной работе</p> <p><u>Подготовка домашнего задания:</u> Подготовка домашнего задания направлена на отработку умений решения профессиональных задач. Домашнее задание выдается студентам по изученному в разделе "Основы физики композиционных материалов" материалу. Дополнительно студенту необходимо изучить литературу и разобрать примеры выполнения подобных заданий. Проверка домашнего задания проводится по представленным письменным работам.</p> <p><u>Подготовка расчетно-графического задания:</u> В рамках расчетно-графического</p>
1.1	1. Основные понятия в области композиционных материалов нанoeлектроники	9		2	-	1	-	-	-	-	-	6	-	
1.2	2. Конденсированная среда: общие характеристики, химическая связь	9		2	-	1	-	-	-	-	-	6	-	
1.3	3. Дислокации в твердых телах	9		2	-	1	-	-	-	-	-	6	-	
1.4	4. Атомное и молекулярное упорядочения	9		2	-	1	-	-	-	-	-	6	-	

													<p>задания выполняется чертёж конструкции. Для выполнения чертежей выполняются предварительные расчёты основных показателей, которые указываются на чертеже. Задание выполняется индивидуально по вариантам. В качестве тем задания применяются следующие:</p> <p><u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Основы физики композиционных материалов"</p> <p><u>Изучение материалов литературных источников:</u> [1], 23-311 [2], 23-245 [3], 14-454</p>	
2	Процессы протекания, перколяция и фрактальные характеристики композиционных материалов	54	12	-	6	-	-	-	-	-	-	36	-	<p><u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u> Проработка лекции, выполнение и подготовка к защите лаб. работы</p> <p><u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Конденсированная среда, дислокации, атомное и молекулярное упорядочения"</p> <p><u>Подготовка расчетно-графического задания:</u> В рамках расчетно-графического задания выполняется чертёж конструкции.</p>
2.1	5. Особенности кластерных кристаллических образований	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	<p>Для выполнения чертежей выполняются предварительные расчёты основных показателей, которые указываются на чертеже. Задание выполняется индивидуально по вариантам. В качестве тем задания применяются следующие:</p> <p><u>Подготовка к контрольной работе:</u> Изучение материалов по разделу "Конденсированная среда, дислокации, атомное и молекулярное упорядочения и подготовка к контрольной работе"</p> <p><u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение материала по разделу "Конденсированная среда, дислокации,</p>
2.2	6. Самоорганизация	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	
2.3	7. Связь электроники и квантовой физики	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	
2.4	8. Простейшие виды низкоразмерных объектов	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	
2.5	9. Атомное молекулярное упорядочение	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	
2.6	10. Особенности свойств, связанные с малым размером частиц	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-	6	-	

													<p>атомное и молекулярное упорядочения" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях <u>Самостоятельное изучение</u> <u>теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Конденсированная среда, дислокации, атомное и молекулярное упорядочения" <u>Изучение материалов литературных</u> <u>источников:</u> [1], 23-311 [2], 23-245 [3], 14-454</p>
3	Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц	18	4	-	2	-	-	-	-	-	12	-	<p><u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u> Проработка лекции, выполнение и подготовка к защите лаб. работы <u>Подготовка расчетно-графического</u> <u>задания:</u> В рамках расчетно-графического задания выполняется чертеж конструкции. Для выполнения чертежей выполняются предварительные расчеты основных показателей, которые указываются на чертеже. Задание выполняется индивидуально по вариантам. В качестве тем задания применяются следующие: <u>Самостоятельное изучение</u> <u>теоретического материала:</u> Изучение дополнительного материала по разделу "Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц" <u>Подготовка к практическим занятиям:</u> Изучение материала по разделу "Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях <u>Подготовка к контрольной работе:</u> Изучение материалов по разделу Особенности структуры и свойств,</p>
3.1	11. Структура поверхности и межфазных границ	9	2	-	1	-	-	-	-	-	6	-	
3.2	12. Нуклеация и рост нанокластеров	9	2	-	1	-	-	-	-	-	6	-	

														<p>связанные с малым размером частиц и подготовка к контрольной работе</p> <p><u>Подготовка домашнего задания:</u> Подготовка домашнего задания направлена на отработку умений решения профессиональных задач. Домашнее задание выдается студентам по изученному в разделе "Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц" материалу. Дополнительно студенту необходимо изучить литературу и разобрать примеры выполнения подобных заданий. Проверка домашнего задания проводится по представленным письменным работам.</p> <p><u>Подготовка к текущему контролю:</u> Повторение материала по разделу "Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц"</p> <p><u>Подготовка расчетных заданий:</u> Задания ориентированы на решения минизаданий по разделу "Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц". Студенты необходимо повторить теоретический материал, разобрать примеры решения аналогичных задач. провести расчеты по варианту задания и сделать выводы. В качестве задания используются следующие упражнения:</p> <p><u>Изучение материалов литературных источников:</u></p> <p>[1], 23-311 [2], 23-245 [3], 14-454</p>
4	Электрическая проводимость сложных гетерогенных систем	18	4	-	2	-	-	-	-	-	12	-	<p><u>Изучение материалов литературных источников:</u></p> <p>[1], 23-311 [2], 23-245 [3], 14-454</p>	
4.1	13.Твердотельные химические реакции	9	2	-	1	-	-	-	-	-	6	-	<p>[1], 23-311 [2], 23-245 [3], 14-454</p>	

4.2	14. Нанокерамики и нанокомпозиты	9	2	-	1	-	-	-	-	-	6	-	
	Зачет с оценкой	18.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	17.7	
	Всего за семестр	144.0	28	-	14	-	-	-	-	0.3	84	17.7	
	Итого за семестр	144.0	28	-	14	-	-	-	-	0.3	101.7		

Примечание: Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПр – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

3.2 Краткое содержание разделов

1. Основы физики композиционных материалов

1.1. 1. Основные понятия в области композиционных материалов наноэлектроники

Основные понятия. Роль и значение материалов в производстве приборов электронной техники. Условная классификация материалов по размеру D частиц (зёрен). Кластерные нанокристаллические, волоконные материалы, плёнки и многослойные материалы, поликристаллические материалы. Каталитическая активность малых частиц. Многослойные наноструктуры: квантовые ямы, сверхрешётки и других структуры с тонкими слоями. Многослойные покрытия. Керамические наноматериалы. Взаимодействие частиц..

1.2. 2. Конденсированная среда: общие характеристики, химическая связь

Центральные и направленные силы между атомами. Металлическая связь. Связи, образованные флуктуирующими диполями. Ковалентная связь. Ионная связь. От ионной связи к ковалентной связи в кристаллах. Силы между молекулами. Электростатическая связь в диэлектрической среде. Индуцированные диполи, поляризуемость. Силы отталкивания. Эмпирические потенциалы взаимодействия. Водородная связь. Силы Ван-дер-Ваальса между макроскопическими частицами. Эффекты запаздывания. Взаимодействие частиц. Частично упорядоченные композиционные нанокристаллические материалы. Прогнозирование поведения свойств композиционных полупроводниковых материалов..

1.3. 3. Дислокации в твердых телах

Пластическая релаксация. Упругость дислокаций. Линейная упругость. Внешние и внутренние напряжения. Упругие поля, связанные с дефектами. Простые топологические характеристики дислокаций. Дислокации в кристаллах. Несовершенные дислокации. Дефекты упаковки и двойники. Линейное натяжение. Элементарные перемещения дислокации. Диффузия точечных дефектов и самодиффузия. Границы зерен и заполнение пространства. Динамические свойства: общие особенности, неустойчивости. Неустойчивости в изначально бездефектных кристаллических частицах..

1.4. 4. Атомное и молекулярное упорядочения

Атомный порядок. Плотность упаковки. Плотная упаковка жестких дисков. Плотная упаковка в трех измерениях. Пустоты между сферами. Роль симметрии. Геометрическая фрустрация. Линии дислокаций. Несоразмерные фазы и квазикристаллы. Молекулярное упорядочение. Пластические кристаллы. Классификация мезоморфных фаз. Нарушения кристаллического порядка. Слабые нарушения. Сильные нарушения. Пространство параметра порядка. Кристаллические твердые тела. Элементы теории групп. Переходы порядок-беспорядок в сплавах. Параметр порядка. Характерные длины.

2. Процессы протекания, перкогация и фрактальные характеристики композиционных материалов

2.1. 5. Особенности кластерных кристаллических образований

Эффективные радиусы ионов. Ионные радиусы химических элементов. Определение ионных и атомных радиусов. Метод изображения кристаллических структур шарами разных размеров. Координационные числа. Типы полиэдров. Геометрические пределы устойчивости структур с различными координационными числами. Поляризация. Поляризация иона в кристалле. Роль химических связей. Зависимость размеров атомов и ионов от координационных чисел. Структурный тип перовскита, шпинели, граната, алмаза и другие типы структур. Слоистые структуры. Стекла и аморфные соединения. Полимеры..

2.2. 6. Самоорганизация

Самоорганизующиеся упорядоченные нанокристаллические структуры. Литографические методы. Нелитографические методы создания периодических структур. Упорядоченные пористые нанокристаллические материалы. Понятие фотонного кристалла. Упорядоченный пористый анодный оксид алюминия. Плазменные методы. Специфика используемого плазменного оборудования.

2.3. 7. Связь электроники и квантовой физики

Основные представления квантовой механики. Квантовая модель атома. Понятие о потенциальных ямах и барьерах. Микрочастица в прямоугольной потенциальной яме. Роль примесных ионов в формировании специальных свойств материалов. Энергетический спектр примесных ионов. Квантовые числа и обозначение энергетических уровней. Туннельный эффект. Квантоворазмерные эффекты. Имплантированные квантовые точки в структуре SiGe..

2.4. 8. Простейшие виды низкоразмерных объектов

Энергетический спектр кристалла. Энергетический спектр электронов и плотность электронных состояний в низкоразмерных областях. Полупроводниковые нанокристаллические материалы в твердотельной электронике..

2.5. 9. Атомное молекулярное упорядочение

Поверхность монокристаллов, нанокластеров и пористых сорбентов. Примесные атомы на поверхности. Молекулярные орбитали. Поверхность металлов и оксидов металлов (электронные свойства). Поверхность металлов и оксидов металла (магнитные свойства). Поверхностные центры кислотного и основного типа. Адсорбция. Катализ. Примеры каталитических превращений с участием поверхности твердого тела и нанокластеров..

2.6. 10. Особенности свойств, связанные с малым размером частиц

Фазовые и структурные состояния в ультрадисперсных средах. Фазовые диаграммы диспергированных систем. Аморфные фазы. Влияние остаточных газов на фазовое равновесие ультрадисперсных частиц с газовой фазой. Образование ультрадисперсных частиц в переохлажденном расплаве. Экспериментальное изучение эффекта нерастворимых примесей. Диффузия. Физико-математические основы диффузии. Гомогенная кристаллизация ультрадисперсных металлических частиц. Физические свойства ультрадисперсных сред. Отличие частиц, полученных методами порошковой металлургии, от ультрадисперсных частиц. Механические свойства. Электрические свойства. Магнитные, оптические и тепловые свойства..

3. Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц

3.1. 11. Структура поверхности и межфазных границ

Поверхность твердых тел. Микроскопические аспекты. Термодинамический подход при анализе свойств поверхности. Химический потенциал. Свободная энергия Гиббса и свободная энергия Гельмгольца. Термодинамика поверхности и поверхностей раздела. Термодинамика криволинейной поверхности. Термодинамические аспекты поверхности. Структура поверхности. Структура поверхности и межфазных границ..

3.2. 12. Нуклеация и рост нанокластеров

Нуклеация и рост нанокластеров в нанопорах вещества. Нуклеация и рост кластеров гидроксида железа в нанопорах. Нуклеация и рост кластеров на основе твердотельных

реакций. Твердотельная нуклеация и рост кластеров. Пример термического разложения оксалата железа. Тонкие пленки. Формирование твердотельных нанокластеров.

4. Электрическая проводимость сложных гетерогенных систем

4.1. 13. Твердотельные химические реакции

Твердотельные химические реакции. Механохимические превращения. Ударно-волновой синтез. Наноструктурирование под действием давления со сдвигом. Наноструктурирование путем кристаллизации аморфных структур. Компактирование (консолидация) нанокластеров. Дефекты и напряжения в твердотельных наноструктурах. Современные композиционные керамические нанокристаллические. Классификация композиционных материалов. Керамика в современной технике..

4.2. 14. Нанокерамики и нанокompозиты

Нанокристаллические материалы (нанокерамики и нанокompозиты). Применение наноразмерных сегнетоэлектрических материалов. Пористая пьезокерамика. Высокочастотные диэлектрические свойства наноразмерных пленок титаната-цирконата свинца. Структурно-чувствительные свойства нанокompозитов. Границы раздела в наноматериалах. Особенности структуры субмикрoкристаллических металлов. Наноструктура неупорядоченных систем. Аномалии механического поведения. Твердофазные топохимические реакции. Тепловые и электрические свойства. Магнитные свойства. . Получение полупроводникового материала. Получение эпитаксиальных структур..

3.3. Темы практических занятий

1. 1. Условная классификация материалов по размеру D частиц (зёрен). Взаимодействие частиц. Эмпирические потенциалы взаимодействия;
2. 2. Эффективные радиусы ионов. Ионные радиусы химических элементов. Типы химических связей. Структурный тип перовскита, шпинели, граната, алмаза;
3. 3. Поверхность монокристаллов, нанокластеров.. Фазовые и структурные состояния в ультрадисперсных средах. Гомогенная кристаллизация ультрадисперсных частиц;
4. 4. Связь электроники и квантовой физики. Понятие о потенциальных ямах и барьерах. Микрочастица в прямоугольной потенциальной яме;
5. 5. Прогнозирование поведения свойств композиционных полупроводниковых материалов. Формирование нанокластеров. Твердотельные химические реакции;
6. 6. Атомные и молекулярные орбитали. Поверхность монокристаллов и нанокластеров. Примесные атомы на поверхности;
7. 7. Количественные характеристики хаоса. Фракталы и сложная упорядоченность. Фракталы и явления роста. Дробная размерность. Основные концепции фракталов.

3.4. Темы лабораторных работ

не предусмотрено

3.5 Консультации

Аудиторные консультации по курсовому проекту/работе (КПР)

1. Консультации направлены на выполнение разделов курсового проекта под руководством наставника (преподавателя). В рамках часов на групповые консультации разбираются наиболее важные части расчетных заданий раздела "Конденсированная среда, дислокации, атомное и молекулярное упорядочения"

Групповые консультации по разделам дисциплины (ГК)

1. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Основы физики композиционных материалов"
2. Консультации проводятся по разделу "Конденсированная среда, дислокации, атомное и молекулярное упорядочения"
3. Обсуждение материалов по кейсам раздела "Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц"
4. Консультации направлены на выполнение разделов курсового проекта под руководством наставника (преподавателя). В рамках часов на групповые консультации разбираются наиболее важные части расчетных заданий раздела "Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц"

Текущий контроль (ТК)

1. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Основы физики композиционных материалов"
2. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Конденсированная среда, дислокации, атомное и молекулярное упорядочения"
3. Консультации проводятся по разделу "Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц"
4. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц"

3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ

Курсовой проект/ работа не предусмотрены

3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

Запланированные результаты обучения по дисциплине (в соответствии с разделом 1)	Коды индикаторов	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.3.1)				Оценочное средство (тип и наименование)
		1	2	3	4	
Знать:						
2. основные физико-математические модели, используемые в области физики полупроводниковых композиционных материалов	ИД-1ПК-3	+				Контрольная работа/КМ-1. Моделирование процессов переноса в композиционных материалах
1. основные процессы, протекающих в композиционных материалах электронной техники,	ИД-1ПК-3	+				Контрольная работа/КМ-1. Моделирование процессов переноса в композиционных материалах
3. влияние структурных характеристик на свойства композиционных материалов;	ИД-2ПК-3		+			Контрольная работа/КМ-2. Протекание в композиционных материалах
4. физико-химические свойства композиционных материалов;	ИД-2ПК-3		+			Контрольная работа/КМ-2. Протекание в композиционных материалах
Уметь:						
2. объяснять на основе физико-математических моделей характеристики полупроводниковых композиционных материалов	ИД-1ПК-3		+			Контрольная работа/КМ-3. Наноккомпозиты
1. применять физико-математические модели при разработке композиционных материалов	ИД-1ПК-3			+		Контрольная работа/КМ-3. Наноккомпозиты
4. рассчитывать электрические характеристики полупроводниковых композиционных материалов для различных областей их использования	ИД-2ПК-3				+	Расчетно-графическая работа/КМ-4. Расчетное задание
3. интерпретировать электрофизические характеристики полупроводниковых и диэлектрических композиционных материалов	ИД-2ПК-3				+	Расчетно-графическая работа/КМ-4. Расчетное задание

4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)

4.1. Текущий контроль успеваемости

8 семестр

Форма реализации: Защита задания

1. КМ-4. Расчетное задание (Расчетно-графическая работа)

Форма реализации: Письменная работа

1. КМ-1. Моделирование процессов переноса в композиционных материалах (Контрольная работа)
2. КМ-2. Протекание в композиционных материалах (Контрольная работа)
3. КМ-3. Нанокompозиты (Контрольная работа)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине

Зачет с оценкой (Семестр №8)

стандартные

В диплом выставляется оценка за 8 семестр.

Примечание: Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Печатные и электронные издания:

1. Гладков, С. О. Физика композитов : учебник для вузов по естественнонаучным направлениям / С. О. Гладков . – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017 . – 332 с. – (Авторский учебник) . - ISBN 978-5-534-01607-9 .;
2. Компьютерное моделирование и конструирование наполненных композиций / Б. А. Люкшин, [и др.], Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т физики прочности и материаловедения ; отв. ред. С. А. Зелепугин . – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2015 . – 264 с. - ISBN 978-8-7692-1434-9 .;
3. В. И. Костиков, Ж. В. Еремеева- "Технология композиционных материалов", Издательство: "Инфра-Инженерия", Москва, Вологда, 2021 - (484 с.)
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617610>.

5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

1. СДО "Прометей";
2. Office / Российский пакет офисных программ;
3. Windows / Операционная система семейства Linux;
4. Видеоконференции (Майнд, Сберджаз, ВК и др);
5. Acrobat Reader.

5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. ЭБС Лань - <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
3. Научная электронная библиотека - <https://elibrary.ru/>
4. База данных ВИНТИ online - <http://www.viniti.ru/>
5. База данных журналов издательства Elsevier - <https://www.sciencedirect.com/>
6. Электронные ресурсы издательства Springer - <https://link.springer.com/>
7. База данных Web of Science - <http://webofscience.com/>

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории, наименование	Оснащение
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и текущего контроля	Е-302, Учебная аудитория каф. "ФТЭМК"	парта со скамьей, стол преподавателя, стол учебный, стул, доска меловая
Учебные аудитории для проведения практических занятий, КР и КП	Е-302, Учебная аудитория каф. "ФТЭМК"	парта со скамьей, стол преподавателя, стол учебный, стул, доска меловая
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий	Е-305, Аудитория для проведения лекционных и практических занятий	рабочее место сотрудника, стеллаж для хранения инвентаря, стол преподавателя, стул, вешалка для одежды, оборудование специализированное
Учебные аудитории для проведения промежуточной аттестации	Е-305, Аудитория для проведения лекционных и практических занятий	рабочее место сотрудника, стеллаж для хранения инвентаря, стол преподавателя, стул, вешалка для одежды, оборудование специализированное
Помещения для самостоятельной работы	Е-316, Лаборатория каф. "ФТЭМК"	стол, шкаф для одежды, шкаф для хранения инвентаря, стол письменный, компьютерная сеть с выходом в Интернет, оборудование специализированное, компьютер персональный, принтер
Помещения для консультирования	Е-305, Аудитория для проведения лекционных и практических занятий	рабочее место сотрудника, стеллаж для хранения инвентаря, стол преподавателя, стул, вешалка для одежды, оборудование специализированное
Помещения для хранения оборудования и учебного инвентаря	Е-301/1, Методический кабинет сотрудников каф. "ФТЭМК"	стол, стул, оборудование специализированное

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Физика композиционных материалов

(название дисциплины)

8 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

КМ-1 КМ-1. Моделирование процессов переноса в композиционных материалах (Контрольная работа)

КМ-2 КМ-2. Протекание в композиционных материалах (Контрольная работа)

КМ-3 КМ-3. Нанокompозиты (Контрольная работа)

КМ-4 КМ-4. Расчетное задание (Расчетно-графическая работа)

Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
		Неделя КМ:	4	8	11	13
1	Основы физики композиционных материалов					
1.1	1. Основные понятия в области композиционных материалов нанoeлектроники		+			
1.2	2. Конденсированная среда: общие характеристики, химическая связь		+			
1.3	3. Дислокации в твердых телах		+			
1.4	4. Атомное и молекулярное упорядочения		+			
2	Процессы протекания, перкогация и фрактальные характеристики композиционных материалов					
2.1	5. Особенности кластерных кристаллических образований			+		
2.2	6. Самоорганизация			+		
2.3	7. Связь электроники и квантовой физики			+		
2.4	8. Простейшие виды низкоразмерных объектов			+		
2.5	9. Атомное молекулярное упорядочение				+	
2.6	10. Особенности свойств, связанные с малым размером частиц				+	
3	Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц					
3.1	11. Структура поверхности и межфазных границ				+	

3.2	12. Нуклеация и рост нанокластеров			+	
4	Электрическая проводимость сложных гетерогенных систем				
4.1	13.Твердотельные химические реакции				+
4.2	14. Нанокерамики и наноккомпозиты				+
Вес КМ, %:		25	25	25	25